This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 1998 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03188567 X-RAY IMAGE SENSOR

PUB. NO.: 02-164067 [JP 2164067 A] June 25, 1990 (19900625) KANO HIROSHI PUBLISHED:

INVENTOR(s): IWASE NOBUHIRO

APPLICANT(s): FUJITSU LTD [000522] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 63-319793 [JP 88319793] December 19, 1988 (19881219) [5] HO1L-027/146; HO4N-005/32 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6 FILED: INTL CLASS:

JAPIO CLASS:

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R115 (X-RAY APPLICATIONS)

Section: E, Section No. 977, Vol. 14, No. 425, Pg. 87, September 13, 1990 (19900913) JOURNAL:

ABSTRACT

PURPOSE: To allow a compact device to read distinct images by X-rays in real time by forming a film with a fluorescent material on a photosensor array which is made up by forming a pattern in the matrix form and constructing an X-ray image sensor.

CONSTITUTION: An X-ray image sensor 1 is driven by connecting it to vertical and horizontal scanning signal generating circuits 2 and 3. When an object 4 receives X-rays 6 irradiated by an X-ray tube 5, the information of the object 4 is converted through a photoelectric system by a photosensor array 7 which makes up the X-ray image sensor 1 and its signals are processed by a calculator 8 and are indicated at an indicating display 9. The X-ray image sensor 1 is formed by forming a fluorescent substance thin film 10 on the photosensor array 7 and once its film receives the X-rays, its thin film 10 emits intense light in proportion to intensity of the X-rays. As resistance values of an amorphous semiconductor film 13 changes in proportion to light intensity of the thin film, effective photoelectric conversion is performed and then subsequent information processing is performed. The X-ray information is thus indicated by displaying the above information in real time.

Topsine Inexaminal Parent Pilin = 2(1990) -

99日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-164067

®Int. Cl. 3

識別配号

庁内签理番号

❸公開 平成2年(1990)6月25日

H 01 L 27/146

8838-5C 7377-5F

H 04 N

H 01 L 27/14 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

X線画像センサ 会発明の名称

> ②特 願 昭63-319793

22出 願 昭63(1988)12月19日

@発 明 者 鹿 博 司

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

個発 明 者

侰 敓 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

勿出 願 人 富士通株式会社

個代 理 人 弁理士 井桁 貞一

1. 発明の名称 X線画像センサ

2. 特許請求の短囲

基板(11)の上にアモルファス半導体膜(13)を挟 んで透明英電膜と薬電膜とからなる複数の信号線 (12)と走査線(14)とがそれぞれ直交するようマト リックス状にパターン形成して椴成してある光セ ンサアレイ (7) の上に、螢光材料を膜形成して 成ることを特徴とするX線函像センサ。

3. 発明の詳細な説明

〔概要〕

X線写真システムを構成するX線画像センサに 関し、

リアルタイムでX線像を電気信号に変換できる センサを実用化することを目的とし、

基板上にアモルファス半退体膜を挟んで送明選 **電膜と事意限とからなる複数の信号線と走査線と**

がそれぞれ直交するようマトリックス状にパター ン形成して松成してある光センサアレイの上に替 光材料を膜形成してX線画位センサを構成する。

〔産梨上の利用分野〕

本発明はX線写真システムを椴成し、リアルタ イムでX線収を包気信号に変換できるX線面像セ ンサに関する。

X線は人体の診断や材料の態識など広い分野に 使用されているが、最大の用途はX線診断である。

そして、X線写真の撮影や透視により診断が行 われているが、X線は放射線であって人体に有客 なことから、被爆線量はなるべく少ないことが必 要で、X線装置の改良とX線フィルム感度の向上 の面から改良が行われており、昔と较べて比較に ならない程に少量のX線で検査が行われるように なっている。

〔従来の技術〕

最近開発された X 線写真システムは X 線否像変

検シートと電算概とを用いて面の処理を行うもので、具体的には従来のフィルムに代わってX 娘面 似変換シートを用いて優彫し、シートに写し込まれた X 線画像をレーザ光を使用して電気信号に変換した後、この信号を電算機で函像処理を行い、この情報をレーザ光の強弱に変換して通常の写真での情報をレーザ光の強弱に変換して通常の写真といれる。

このような方法によると従来に较べて数10分の 1以下の線量で鮮明な函像を得ることができる。

こゝで、X線面像変換シートは放射線エネルギーを一旦蓄積でき、あとで熱や光の励起によって再び弧光を発すを輝尽性弧光体を感光材料とするシートである。

すなわち、X線画像変換シートはポリエチレンテレフタレートなどの送明樹脂膜の上に、アルカリ土類金属のハロゲン化物とハロゲン化ユーロピウムとの混合物を選元ガス中で焼成して二個のユーロピウム賦活ハロゲン化アルカリ土類金属観光体を作り、かゝる輝尽性観光体をパインダと混

いて検出し、光虹子倍増替で世気信号に変換して 記録するものである。

このようにX線函位変換シートを用いるX線写真システムは情報を記録することができ、明瞭なX線函位を得られると云う利点はあるが、情報の読み出しに時間を要し、また装置も複雑になるという欠点があり、リアルタイムで読みだすと云う目的には沿っていない。

そこで、小型の装置で鮮明なX線面像をリアルタイムで説みだすことのできるX線面像装置が求められている。

(発明が解決しようとする課題)

以上記したように鲜明なX線函像をリアルタイムで読み出すことができ、且つ小型のX線函像装置を実用化することが課題である。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は従来より使用されている光センサアレイに弦光体容限を被阻してX線面低センサを作る

合して基材フィルム上に添付し、この上に接着剤 を用いてポリエチレンテレフタレートの薄膜を貼 着してシート状として使用している。

このような奴尽性盤光体については既に各種の研究が行われており、最も優れた奴尽性盤光体として二価のユーロビウム既活塩化臭化バリウム(Bac & Br: Eu*) が発表されている。

こゝで、紅尽性螢光発光の原理は強光体結晶に X線が照射されると、価電子帯にある電子が伝導 電子帯に励起されるが、直ちに禁止帯にある不純 物単位に落ち込んで安定化する。

次に、銃み取りのためにレーザ光を照射すると 不純物印位にある電子はレーザ光のエネルギーを 吸収して伝導電子帯に励起された後、もとの価電

子帯に落ちるが、この際に螢光帯は螢光を発生し、

その明るさは不純物単位の捕取電子型に比例する。

これがX線エネルギーの蓄積記録に対応する。

以上のことから、X線函像変換シートの衷面を 数少スポット(直径約100 μο)のレーザ光で走 在して、各百届毎の観光発光を干渉フィルタを用

もので、このセンサを従来の衷示装置に接続して 西位衷示を行うものである。

すなわち、X線面位センサは基板上にアモルファス半率体限を挟んで送明取電膜と弱電膜とからなる複数の信号線と走査線とがそれぞれ直交するようマトリックス状にパターン形成して棉成してある光センサアレイの上に螢光材料を股形成してX線面位センサを構成することにより解決することができる。

(作用)

第2図はX線写真システムの构成を示すもので、 第1図に断面構造を示す本発明に係るX線画像センサ1以外の表示回路は従来の表示装置と変わらない。

すなわち、第2図において、X線画像センサ1はこれを招成する垂直方向の信号線と、これと直交する水平方向の走査線が、それぞれ垂直走査信号発生回路(略してY方向ドライブ回路)2と水平走査信号発生回路(X方向ドライブ回路)3に

接続されて駆動されており、被写体4がX線管5より照射されるX線6を受けるとX線強度の強弱の分布として変される被写体4の俯報は、X線面像センサ1を抑成する光センサアレイ7で光電変換され、この信号は計算機8で処理して表示ディスプレイ9に表示される。

次に、光センサアレイ7は石英ガラスなどからなる基板11の上に写真触刻技術(フォトリソグラフィ)によりパターン形成した悪電際からなる信号線12があり、この上に光悪電体材料としてアモルファス半導体膜13があり、更にこの上に先の信号線12に直交するように透明導電限からなる走査線14がパターン形成されて光センサアレイ7が構成されている。

本発明はからる光センサアレイ7の上に質光体 薄限10を形成することによりX線面像センサ1を 形成するもので、X線を受けて観光体辺障10かX

次に、この上に先と同様にSnO。をスパッタして幅100 μロ. 厚さ 1 μロ の多数の X 方向の走査線 14をパターン形成し、マトリックス電極を鍛えた 光センサアレイ 7 の形成が終わった。

次に、観光材料として硫化亜鉛(2nS)を用い、 真空度 1×10⁻³torr、蒸着速度100 A/分の条件 で電子ピーム蒸着を行い、厚さが 1 μ ロ の観光体 薄膜10を形成し、これにより X 線画像センサ 1 が 完成した。

か、る X 線函像センサ 1 を用い、第 2 図に示す X 線写真システムを協成して実験した結果、従来 の X 線函像変換シートを用いた写真システムと同 様に鮮明な函像を表示ディスプレイ 9 に表示する ことができた。

(発明の効果)

以上記したように、本発明の実施によりリアルタイムでX線情報を表示ディスプレイすることが可能となる。

娘強度に比例した強度の発光をし、この発光效度 に比例してアモルファス半悪体限13の抵抗値が変 化することから効果的な光気変損が行われ、以後 値観処理が行われるものである。

なお、設光材料としては硫化亜鉛(ZaS)、タングステン酸カルシウム(CaHOs)、ユーロピウム添加 弗化塩化パリウム(BaFC &: Eu**)などを挙げる ことができる。

(実施例)

第1図に示す断面図において、基板11としては300 中角で厚さが3中の石英ガラスを使用し、この上に酸化锅(SnO₂)をスパッタして透明基電膜を作り、これに写真触刻技術を用いて昭100 μって厚さが1μο の多数の Y 方向の信号級12をパターン形成した。

この上にセレン・砒索・テルル(Se-As-Te)からなるアモルファス半退体を貫子ピーム蒸着してアモルファス半退体設13を0.5 μα の厚さに成設した。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係るX線画像センサの部分断 節図。

第2図はX線写真システムの榕成図、 である。

図において、

1はX線函像センサ、 4は被写体、

5 は X 線管、 7 は光センサアレイ、

10は螢光体部膜、 11は基板、

12は信号線、

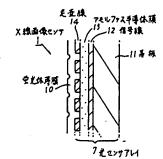
13はアモルファス半退体膜、

14は走査線、

である.

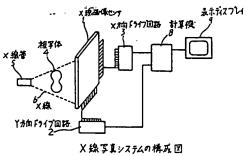
代理人 弁理士 井桁 貞一





本党明に係るX線画像センナの部分断面図

35 1 **27**



₹ 2 **2**